

日程表 (会場別 I)

会場名	収容人数	2018年9月18日(火)		2018年9月19日(水)		2018年9月20日(木)		2018年9月21日(金)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
1号館	CE (セネリアホール)	3000	10:00 ~ 12:00 SP2 インフォマティクスへの招待 ～ 機械学習・インフォマティクスは応用物理をどう変えるか? ～	13:00 ~ 18:30 SP7 インフォマティクスへの招待 ～ 機械学習・インフォマティクスは応用物理をどう変えるか? ～	09:00 ~ 11:55 S21 日韓ジョイントシンポジウム ～ インドキヤップ半導体デバイス	13:00 ~ 14:45 S21 日韓ジョイントシンポジウム ～ インドキヤップ半導体デバイス	09:00 ~ 12:15 13.5 デバイス/集積化技術	13:30 ~ 17:45 SP3 GaNのピタキシャル成長とデバイス科学	09:00 ~ 11:30 13.5 デバイス/集積化技術	13:30 ~ 17:25 S9 IoTに資する高周波デバイスにおける機能性酸化物の役割
	131 (131+132)	158	09:00 ~ 11:45 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	16:00 ~ 17:30 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	09:00 ~ 12:00 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	13:30 ~ 17:45 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	09:00 ~ 12:00 CS.9 10.1新物質・新機能創成 (作製・評価技術), 10.2 スピン基礎技術・萌芽的デバイス技術, 10.3スピンドバイス・磁気メモリストレージ技術, 10.4半導体スピントロニクス・超伝導・強相関のコードシェアセッション	13:00 ~ 15:15 CS.9 10.1新物質・新機能創成 (作製・評価技術), 10.2 スピン基礎技術・萌芽的デバイス技術, 10.3スピンドバイス・磁気メモリストレージ技術, 10.4半導体スピントロニクス・超伝導・強相関のコードシェアセッション	09:00 ~ 12:00 10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関	13:00 ~ 14:45 10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関
	133 (133+134)	158		13:30 ~ 17:45 S18 化合物カルコゲナイド太陽電池の最新技術 - CIGS系・CZTS系・CTS系太陽電池の高効率化とその課題 -	09:00 ~ 12:15 6.1 強誘電体薄膜	13:45 ~ 19:00 6.1 強誘電体薄膜	09:30 ~ 11:45 16.3 シリコン系太陽電池	13:45 ~ 17:45 16.3 シリコン系太陽電池	09:30 ~ 11:45 16.3 シリコン系太陽電池	13:45 ~ 17:00 16.3 シリコン系太陽電池
	135 (135)	72		13:30 ~ 16:00 チュートリアル(有料) 超伝導量子回路と量子コンピュータ (蔡兆申)	09:00 ~ 12:10 チュートリアル(有料) 真空の世界: 真空技術の基礎 (栗原 善揮)	14:00 ~ 17:30 S1 科学技術の人材育成および教育の取り組みとその活性化 - 東海地区 -	09:00 ~ 11:30 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス		09:00 ~ 11:45 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	13:00 ~ 17:15 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション
	136 (3Fロビー)	108	09:00 ~ 12:15 3.7 レーザープロセッシング	13:45 ~ 18:00 3.7 レーザープロセッシング	09:00 ~ 12:15 13.9 化合物太陽電池	13:45 ~ 15:45 13.9 化合物太陽電池	09:30 ~ 12:00 13.9 化合物太陽電池	13:30 ~ 16:15 13.9 化合物太陽電池	09:00 ~ 12:15 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野	13:45 ~ 16:00 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野
	141 (141+142)	350		13:00 ~ 17:50 SPI 自動運転とLiDAR	09:00 ~ 10:30 8.1 プラズマ生成・診断 10:45 ~ 11:45 8.8 プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演 11:45 ~ 12:15 8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	13:30 ~ 17:15 S12 プラズマ・インフォマティクス～ビッグデータ解析の活用によるプラズマ科学の発展～	09:00 ~ 12:30 15.6 IV族系化合物 (SiC)	13:30 ~ 18:30 S23 強誘電体HfO2技術の最新動向～プロセス・物性からデバイス・回路応用まで～	09:00 ~ 12:30 15.6 IV族系化合物 (SiC)	13:30 ~ 17:45 S16 日韓の有機エレクトロニクス研究II: 基礎研究と応用研究の観点から
	143 (143)	72	09:30 ~ 11:45 6.6 フロー顕微鏡	13:45 ~ 17:45 6.6 フロー顕微鏡	09:30 ~ 11:45 6.6 フロー顕微鏡	13:45 ~ 17:30 11.1 基礎物性	09:30 ~ 11:45 11.1 基礎物性	13:45 ~ 17:00 11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	09:00 ~ 12:00 CS.6 3.11フォトニック構造・現象, 13.67 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェアセッション	
	144 (4Fロビー)	108		13:00 ~ 18:20 S14 ナノバイオ・ナノ医療にむかう技術イノベーション～材料・デバイスから計測まで～				13:30 ~ 18:35 S22 Poly-Si TFTのルネサンスと新展開	09:00 ~ 12:30 8.4 プラズマサイエンス	
	145 (レセプションホール)	276	09:00 ~ 11:45 12.4 有機EL・トランジスタ	13:30 ~ 17:25 S17 金属ハライドペロブスカイト型物質の応用物理	09:00 ~ 11:45 12.4 有機EL・トランジスタ	13:45 ~ 18:00 12.4 有機EL・トランジスタ	09:00 ~ 12:15 12.4 有機EL・トランジスタ	13:30 ~ 16:35 S6 量子コンピュータと量子シミュレーションの現状と展望 II	09:00 ~ 11:30 13.3 絶縁膜技術	13:15 ~ 17:00 13.3 絶縁膜技術
	146 (レセプションホール)	276	09:00 ~ 12:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 18:00 S25 窒化物半導体特異構造の科学～窒化物プロセス技術の最新展開～	09:00 ~ 12:15 15.4 III-V族窒化物結晶	13:15 ~ 19:15 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:15 15.4 III-V族窒化物結晶	13:45 ~ 16:15 8.4 プラズマサイエンス	09:00 ~ 12:15 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 18:00 15.4 III-V族窒化物結晶
	211A (211-1)	100		13:15 ~ 18:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	09:00 ~ 11:45 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:15 ~ 14:45 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	09:15 ~ 12:00 3.6 超高速・高強度レーザー	13:15 ~ 18:15 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	09:15 ~ 12:15 3.6 超高速・高強度レーザー	13:30 ~ 17:15 3.6 超高速・高強度レーザー
	211B (211-2)	100	09:15 ~ 11:45 4.1 Plasmonics and Nanophotonics	13:15 ~ 18:15 4.1 Plasmonics and Nanophotonics	09:15 ~ 11:45 4.1 Plasmonics and Nanophotonics	13:15 ~ 18:00 4.1 Plasmonics and Nanophotonics	09:00 ~ 11:45 4.8 Quantum Optics and Nonlinear Optics	13:15 ~ 16:15 4.8 Quantum Optics and Nonlinear Optics	09:00 ~ 11:45 4.2 Photonic Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonics	13:15 ~ 16:15 4.2 Photonic Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonics
	212A (212-1)	100	09:30 ~ 11:45 3.15 シリコンフォトニクス	13:15 ~ 17:30 3.15 シリコンフォトニクス		13:15 ~ 16:30 3.14 光制御デバイス・光ファイバー	09:15 ~ 12:00 3.9 テラヘルツ全般	13:15 ~ 17:30 3.9 テラヘルツ全般	09:00 ~ 11:45 3.9 テラヘルツ全般	13:15 ~ 14:45 3.9 テラヘルツ全般
	212B (212-2)	49		13:30 ~ 16:45 CS.8 7.4量子ビーム界面構造計測, 9.5新機能材料・新物性のコードシェアセッション	09:15 ~ 12:00 1.3 新技術・複合新領域	13:15 ~ 17:15 11.3 臨界電流, 超伝導バワー応用	09:00 ~ 11:00 11.4 アナログ応用および関連技術	13:15 ~ 17:15 11.4 アナログ応用および関連技術	09:00 ~ 12:00 11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	
221A (221-1)	49			09:00 ~ 11:45 9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	13:15 ~ 18:15 9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子			09:30 ~ 11:30 9.3 ナノエレクトロニクス	13:00 ~ 14:30 9.3 ナノエレクトロニクス	
221B (221-2)	60		13:15 ~ 18:30 4.6 Terahertz Photonics		09:15 ~ 12:00 CS.2 3.3情報フォトニクス・画像工学, 4.4Information Photonicsのコードシェアセッション	13:15 ~ 16:30 CS.2 3.3情報フォトニクス・画像工学, 4.4Information Photonicsのコードシェアセッション	13:15 ~ 17:15 4.5 Nanocarbon and 2D Materials	09:45 ~ 11:45 4.3 Ultrafast Optics and Photonics	13:15 ~ 14:45 4.3 Ultrafast Optics and Photonics	
221C (2Fランジ)	100	09:00 ~ 11:45 12.7 医用工学・バイオチップ	13:15 ~ 15:30 12.7 医用工学・バイオチップ		13:15 ~ 17:45 12.7 医用工学・バイオチップ	09:00 ~ 11:45 12.7 医用工学・バイオチップ	13:45 ~ 18:00 15.6 IV族系化合物 (SiC)			
222 (222)	108	09:00 ~ 12:00 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:30 ~ 17:15 12.6 ナノバイオテクノロジー	09:00 ~ 10:30 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:30 ~ 17:00 12.6 ナノバイオテクノロジー	09:00 ~ 12:15 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:15 ~ 19:30 6.2 カーボン系薄膜	09:00 ~ 12:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:15 ~ 15:15 7.5 イオンビーム一般	
223 (223)	108	09:15 ~ 11:45 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:15 ~ 18:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	09:00 ~ 12:15 S2 加速質量分析の最新動向と展望	13:45 ~ 16:55 S3 研究切り拓(未来の研究・次世代の人材育成)		13:45 ~ 18:45 S24 アトミックレイヤープロセスの現状と展望		13:15 ~ 16:30 7.2 電子ビーム一般	
224A (224-1)	130	11:00 ~ 11:40 Exhibition Award表彰式 講演奨励賞贈呈式	15:45 ~ 16:30 代議員会議 16:30 ~ 18:45 功労会員表彰式, 論文賞贈呈式, フォト表彰式	09:30 ~ 11:30 21.1 合同セッションK「フワイドキャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:00 ~ 15:15 21.1 合同セッションK「フワイドキャップ酸化物半導体材料・デバイス」	09:00 ~ 11:45 3.7 レーザープロセッシング	13:15 ~ 18:00 3.12 ナノ領域光学・近接場光学	09:00 ~ 11:45 3.12 ナノ領域光学・近接場光学	13:15 ~ 16:45 3.12 ナノ領域光学・近接場光学	
224B (224-2)	80	09:00 ~ 11:45 17.3 層状物質	13:15 ~ 16:00 17.3 層状物質	09:00 ~ 11:45 17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料	13:15 ~ 18:45 17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料	09:00 ~ 11:45 2.1 放射線物理一般・検出器基礎	13:30 ~ 15:30 2.1 放射線物理一般・検出器基礎	09:00 ~ 12:00 2.2 検出器開発	13:00 ~ 15:00 2.2 検出器開発	
225A (225)	42		13:15 ~ 16:30 1.1 応用物理一般・学際領域							
225B (2Fランジ)	100	09:30 ~ 11:45 3.11 フォトニック構造・現象		09:00 ~ 11:30 CS.5 3.11フォトニック構造・現象, 3.13半導体光デバイス, 3.15シリコンフォトニクスのコードシェアセッション	13:15 ~ 17:15 3.11 フォトニック構造・現象	09:00 ~ 12:00 CS.4 3.11フォトニック構造・現象, 3.12 ナノ領域光学・近接場光学のコードシェアセッション	13:30 ~ 16:20 S11 クライオ電子顕微鏡最前線			

日程表 (会場別Ⅱ)

会場名	収容人数	2018年9月18日(火)		2018年9月19日(水)		2018年9月20日(木)		2018年9月21日(金)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
2号館	231A (231-1)	49	09:30 ~ 11:45 1.5 計測技術・計測標準	13:15 ~ 17:30 1.5 計測技術・計測標準	09:00 ~ 10:30 16.2 エナジーハーベスティング	13:15 ~ 15:30 16.1 基礎物性・評価・プロセスデバイス	09:00 ~ 11:45 9.1 誘電材料・誘電体	13:15 ~ 16:00 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境		
	231B (231-2)	60	10:00 ~ 12:00 1.6 超音波	13:15 ~ 17:45 2.3 放射線応用・発生装置・新技術		13:15 ~ 16:45 4.7 Laser Material Processing and Manipulation		13:15 ~ 17:15 12.2 評価・基礎物性		
	231C (3Fフロンジ1)	100	09:30 ~ 12:15 3.1 光学基礎・光学新領域	13:15 ~ 18:30 3.1 光学基礎・光学新領域	09:00 ~ 11:45 12.1 作製・構造制御	13:15 ~ 18:15 12.1 作製・構造制御	10:00 ~ 12:00 S15 深化する有機半導体結晶; 量子解放の分子科学に向けて	13:30 ~ 17:30 S15 深化する有機半導体結晶; 量子解放の分子科学に向けて	09:00 ~ 12:00 12.2 評価・基礎物性	13:15 ~ 16:00 12.2 評価・基礎物性
	232 (232)	108	09:00 ~ 12:00 3.13 半導体光デバイス	13:15 ~ 18:00 3.13 半導体光デバイス		13:30 ~ 17:20 S5 光AIの最新動向	10:00 ~ 11:30 CS.1 3.2材料・機械光学, 12.3機能材料・萌芽的デバイスのコードシェアセッション	13:30 ~ 16:45 S7 フォトニクスが生み出すイノベーションと新産業創出	09:00 ~ 12:00 6.2 カーボン系薄膜	13:15 ~ 18:00 6.2 カーボン系薄膜
	233 (233)	108	09:30 ~ 12:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	13:30 ~ 18:30 S4 エピタキシャル・パワーレーザー ~ 科学のフロンティア開拓から先端技術の社会実装まで	09:00 ~ 12:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	13:30 ~ 17:50 S19 材料・プロセスが切り開く未来半導体デバイス	09:30 ~ 11:45 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	13:30 ~ 18:00 S20 ナノエレクトロニクス材料・デバイス研究開発を旨とした先端イオン顕微鏡技術	09:00 ~ 12:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	13:00 ~ 16:45 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術
	234A (234-1)	130	09:00 ~ 10:15 8.6 Plasma Electronics English Session 10:30 ~ 12:00 8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演 12:00 ~ 12:45 8.6 Plasma Electronics English Session			13:30 ~ 16:15 7.3 微細/ナノ・微細構造形成技術	09:00 ~ 12:00 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:30 ~ 18:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	09:00 ~ 11:30 3.4 生体・医用光学	13:15 ~ 17:45 3.4 生体・医用光学
	234B (234-2)	80		13:15 ~ 18:30 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	09:15 ~ 11:45 6.4 薄膜新材料	13:15 ~ 18:30 6.4 薄膜新材料	09:00 ~ 11:45 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	13:15 ~ 18:00 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	09:15 ~ 11:45 6.4 薄膜新材料	13:15 ~ 15:30 6.4 薄膜新材料
235 (3Fフロンジ2)	90	09:30 ~ 11:45 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	13:15 ~ 17:00 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	09:45 ~ 11:30 13.8 光物性・発光デバイス	13:30 ~ 17:00 13.8 光物性・発光デバイス	09:30 ~ 11:30 13.8 光物性・発光デバイス	13:30 ~ 17:30 13.8 光物性・発光デバイス	10:00 ~ 12:00 7.1 X線技術	13:30 ~ 16:45 7.1 X線技術	
3号館	311 (カケード)	200		19:00~21:00 懇親会 (有料)	09:00 ~ 12:15 17.3 腐状物質	13:30 ~ 17:15 S27 フォンデルワールス積層ヘテロデバイスの最前線 17:30 ~ 19:00 17.2 グラフェン	09:00 ~ 12:15 17.2 グラフェン	13:45 ~ 18:30 17.2 グラフェン	09:00 ~ 12:45 17.2 グラフェン	
	331 (国際会議室)	336		13:30 ~ 17:30 SP4 最先端プラズマ科学技術が創る未来社会 ~半導体から医療・農業・宇宙探査まで~	09:00 ~ 10:30 10.2 スピン基礎技術・萌芽的デバイス技術 10:45 ~ 12:15 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術	13:45 ~ 17:00 S13 スピンロニクス材料研究の新潮流 ~二次元系を中心し~	09:00 ~ 12:30 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13:45 ~ 17:15 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	09:00 ~ 12:15 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13:45 ~ 16:00 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術
	431B (431-2)	56	10:00 ~ 12:15 6.5 表面物理・真空	13:45 ~ 17:15 CS.7 6.5表面物理・真空, 7.6原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション	09:00 ~ 10:30 3.5 レーザー装置・材料 10:45 ~ 12:00 CS.3 3.5レーザー装置・材料, 3.14光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション	13:45 ~ 18:45 3.5 レーザー装置・材料	09:00 ~ 12:15 10.5 磁場応用	13:45 ~ 17:30 3.3 情報フォトニクス・画像工学	09:00 ~ 12:00 15.1 ハルク結晶成長	13:45 ~ 15:30 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶
4号館	432 (432)	180	09:30 ~ 12:00 S8 超スマート社会に向けての固体イオニクスデバイス ~基礎から情報通信、人工知能、電池への応用まで~	13:30 ~ 17:30 S8 超スマート社会に向けての固体イオニクスデバイス ~基礎から情報通信、人工知能、電池への応用まで~	09:00 ~ 12:15 12.5 有機太陽電池	13:45 ~ 17:30 S10 3次元積層集積デバイスによる半導体集積回路技術の進展と展望	09:00 ~ 12:15 12.5 有機太陽電池	14:00 ~ 18:00 S26 シリカガラスの最前線	09:00 ~ 12:15 12.5 有機太陽電池	13:45 ~ 18:00 12.5 有機太陽電池
	436 (436)	47			09:30 ~ 11:45 13.2 探索的材料物性・基礎物性	13:45 ~ 18:45 13.2 探索的材料物性・基礎物性		13:45 ~ 15:45 3.2 材料・機器光学		
	437 (437)	47			09:00 ~ 12:30 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	13:45 ~ 18:00 9.5 新機能材料・新物性	09:00 ~ 12:00 8.3 プラズマナノロジー			
	438 (3Fフロンジ)	140	09:30 ~ 11:30 3.10 光量子物理・技術	13:45 ~ 16:45 3.10 光量子物理・技術	09:00 ~ 12:15 3.8 光計測技術・機器	13:45 ~ 19:00 3.8 光計測技術・機器	09:00 ~ 12:15 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	13:45 ~ 19:15 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	09:15 ~ 12:00 9.4 熱電変換	13:45 ~ 17:15 9.4 熱電変換
イベントホール (PA)	PA1 ~ PA10		[13:30-15:30] 1.6 超音波 6.4 薄膜新材料 16.1 基礎物性・評価・プロセスデバイス	[13:30-15:30] 1.6 超音波 6.4 薄膜新材料 16.1 基礎物性・評価・プロセスデバイス	[09:30-11:30] 1.2 教育 3.1 光学基礎・光学新領域 3.6 超高速・高強度レーザー 3.7 レーザープロセス 3.10 光量子物理・技術	[13:30-15:30] 1.1 応用物理一般・学際領域 1.3 新技術・複合新領域 3.15 シリコンフォトニクス 15.4 III-V族窒化物結晶 16.3 シリコン系太陽電池	[09:30-11:30] 7.1 ビーム応用 12.2 評価・基礎物性 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 13.2 探索的材料物性・基礎物性 13.3 絶縁体技術 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	[16:00-18:00] 8.1 プラズマ生成・診断 8.4 プラズマライファイエンス 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野 8.6 Plasma Electronics English Session	[09:30-11:30] 3.2 材料・機器光学 12.1 作製・構造制御 13.8 光物性・発光デバイス	
	PA11 ~ PA10		[16:00-18:00] 3.8 光計測技術・機器 12.4 有機EL・トランジスタ 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	[16:00-18:00] 3.8 光計測技術・機器 12.4 有機EL・トランジスタ 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	[16:00-18:00] 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学 9.4 熱電変換 22 合同セッション「フォノンエンジニアリング」	[16:00-18:00] 13.9 化合物太陽電池 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶 21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	[16:00-18:00] 6.1 強誘電体薄膜 6.2 カーボン系薄膜 CS.2 3.3情報フォトニクス・画像工学, 4.Information Photonicsのコードシェアセッション	[16:00-18:00] 2 放射線 3.4 生体・医用光学		
白鳥ホール (PB)	PB1 ~ PB10		[13:30-15:30] 10 スピンロニクス・マグネティクス 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	[13:30-15:30] 10 スピンロニクス・マグネティクス 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	[09:30-11:30] 9.5 新機能材料・新物性 11 超伝導	[13:30-15:30] 6.3 酸化物エレクトロニクス 6.5 表面物理・真空 6.6 フロー顕微鏡 7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術	[09:30-11:30] 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境 3.5 レーザー装置・材料 3.9 テラヘルツ全般 3.13 半導体光デバイス 3.14 光制御デバイス・光ファイバー 4.1 Plasmonics and Nanophotonics 4.2 Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonics	[13:30-15:30] 9.1 誘電材料・誘電体 9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子 9.3 ナノエレクトロニクス 12.5 有機太陽電池	[13:30-15:30] 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理 8.3 プラズマナノロジー 13.5 デバイス/集積化技術 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス 15.1 ハルク結晶成長 15.6 IV族系化合物 (SiC)	
	PB11 ~ PB10		[16:00-18:00] 17 ナノカーボン	[16:00-18:00] 17 ナノカーボン		[16:00-18:00] 13.9 化合物太陽電池 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶 21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	[16:00-18:00] 6.1 強誘電体薄膜 6.2 カーボン系薄膜 CS.2 3.3情報フォトニクス・画像工学, 4.Information Photonicsのコードシェアセッション	[16:00-18:00] 2 放射線 3.4 生体・医用光学		